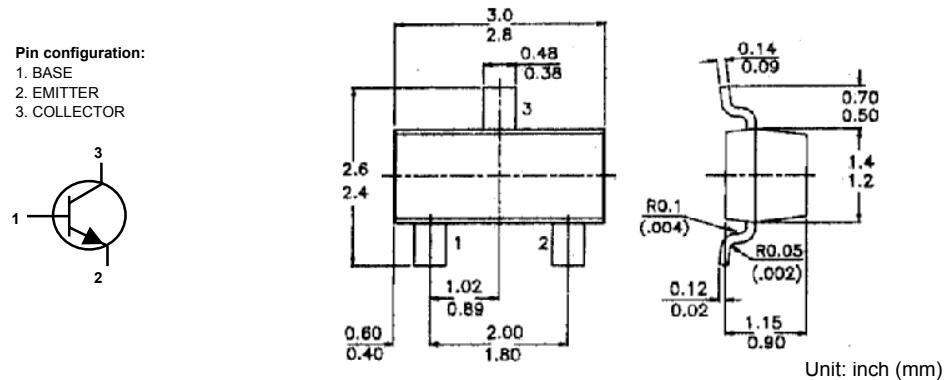


NPN Silicon Planar Epitaxial Transistors



SOT-23 SMD Package

Absolute Maximum Ratings ($T_a = 25^\circ\text{C}$ unless specified otherwise)

DESCRIPTION	SYMBOL	BC846	BC847	BC848	UNITS
Collector Base Voltage	V_{CBO}	80	50	30	V
Collector Emitter Voltage ($V_{BE} = 0V$)	V_{CES}	80	50	30	V
Collector Emitter Voltage	V_{CEO}	65	45	30	V
Emitter Base Voltage	V_{EBO}	6	6	5	V
Collector Current (DC)	I_C		100		mA
Collector Current - Peak	I_{CM}		200		mA
Emitter Current - Peak	$-I_{EM}$		200		mA
Base Current - Peak	I_{BM}		200		mA
Total power dissipation up to $T_{amb} = 25^\circ\text{C}$	P_{tot}^{**}		250		mW
Storage Temperature	T_{stg}		-55 to +150		$^\circ\text{C}$
Junction Temperature	T_j		150		$^\circ\text{C}$

Thermal Resistance

From junction to ambient	$R_{th(j-a)}^{**}$	500	K/W
--------------------------	--------------------	-----	-----

**Mounted on a ceramic substrate of 8mm x 10mm x 0.7mm

Electrical Characteristics (at $T_a=25^{\circ}\text{C}$ unless otherwise specified)

DESCRIPTION	SYMBOL	TEST CONDITION	MIN	TYP	MAX	UNITS
Collector Cut Off Current	I_{CBO}	$V_{CB} = 30\text{V}, I_E = 0$ $V_{CB} = 30\text{V}, I_E = 0, T_j = 150^{\circ}\text{C}$		15	nA	
				4	uA	
Base Emitter On Voltage	$V_{BE(on)}^*$	$I_C = 2\text{mA}, V_{CE} = 5\text{V}$ $I_C = 10\text{mA}, V_{CE} = 5\text{V}$	0.58	0.7	0.77	V
Collector Emitter Saturation Voltage	$V_{CE(Sat)}$	$I_C = 10\text{mA}, I_B = 0.5\text{mA}$ $I_C = 100\text{mA}, I_B = 5\text{mA}$		0.25	0.60	V
Base Emitter Saturation Voltage	$V_{BE(Sat)}^{***}$	$I_C = 10\text{mA}, I_B = 0.5\text{mA}$ $I_C = 100\text{mA}, I_B = 5\text{mA}$	0.7	0.7	0.9	V
DC Current Gain	h_{FE}	$I_C = 10\text{uA}, V_{CE} = 5\text{V}$ BC846A/BC847A/BC848A BC846B/BC847B/BC848B BC847C/BC848C $I_C = 2\text{mA}, V_{CE} = 5\text{V}$ BC846 BC847/BC848 BC846A/BC847A/BC848A BC846B/BC847B/BC848B BC847C/BC848C	90	150	270	
Collector Capacitance	C_C	$I_E = i_e = 0, V_{CB} = 10\text{V}, f = 1\text{MHz}$	2.5			pF
Transition Frequency	f_T	$I_C = 10\text{mA}, V_{CB} = 5\text{V}, f = 100\text{MHz}$	100			MHz
Small Signal Current Gain	$ h_{fe} $	$I_C = 2\text{mA}, V_{CE} = 5\text{V}, f = 1\text{kHz}$ BC856 BC857/BC858 BC846A/BC847A/BC848A BC846B/BC847B/BC848B BC847C/BC848C	125	500	900	
Noise Figure	NF	$I_C = 0.2\text{mA}, V_{CE} = 5\text{V}$ $R_S = 2\text{k ohm}, f = 1\text{kHz}, B = 200\text{Hz}$	10			dB

* $V_{BE(on)}$ decreases by about 2mV/K with increase temperature.

*** $V_{BE(Sat)}$ decreases by about 1.7mV/K with increase temperature.



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литер Н,
помещение 100-Н Офис 331